

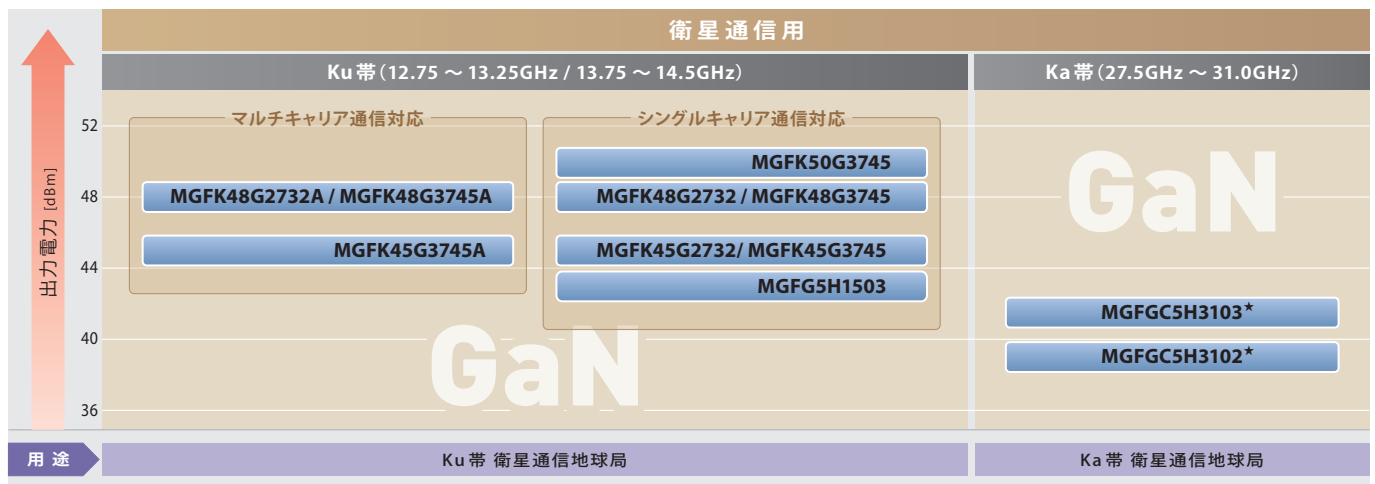
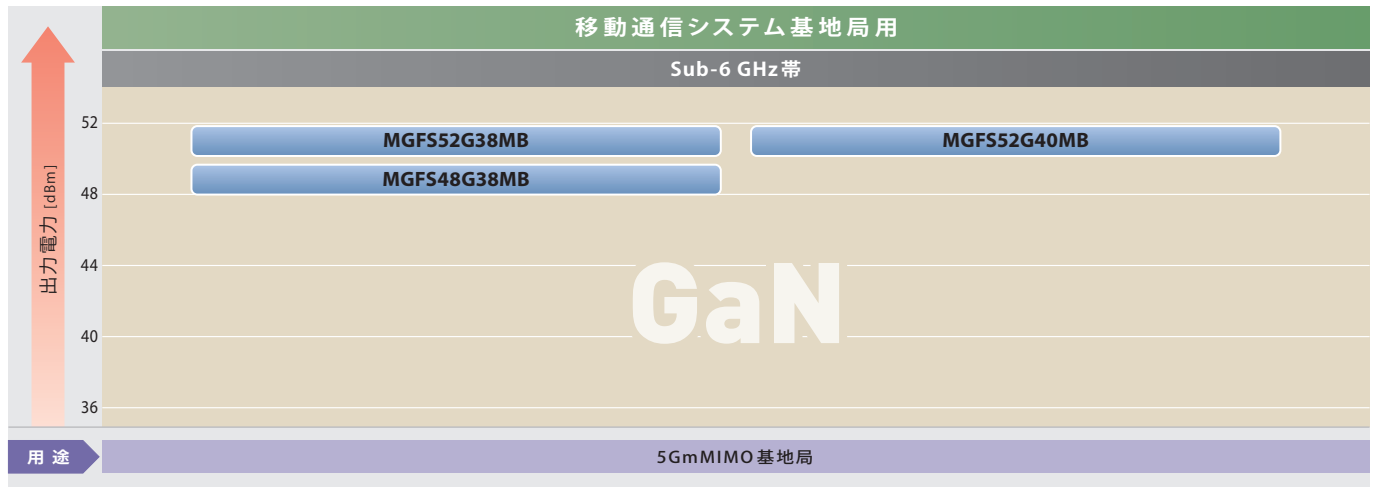
三菱高周波デバイス

HIGH FREQUENCY DEVICES

ICT社会の実現をサポートする 三菱高周波デバイス

セレクションマップ

■高出力 GaN HEMT

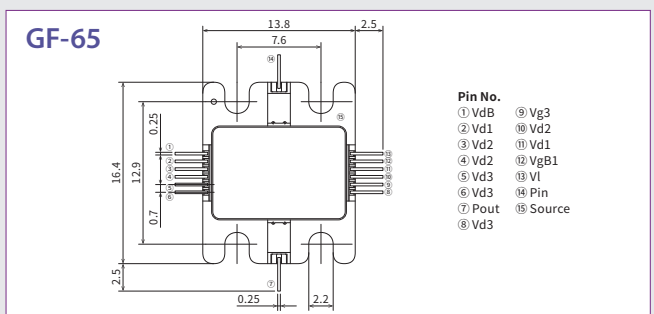
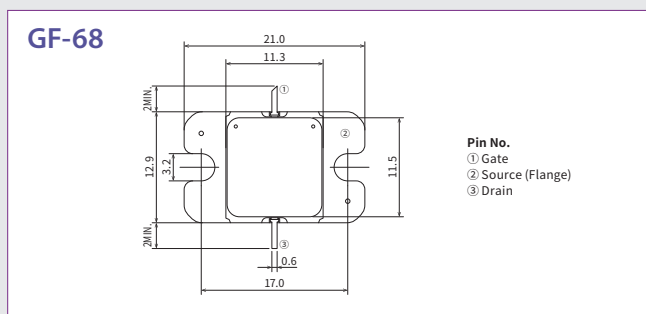
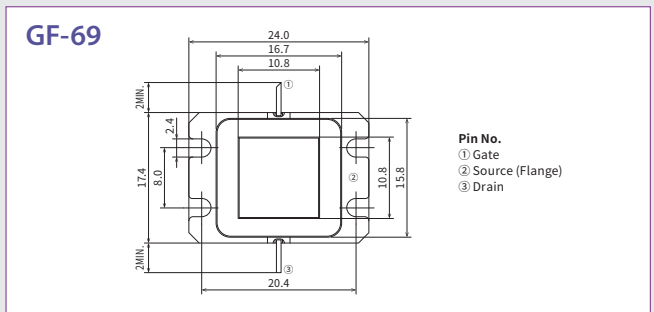
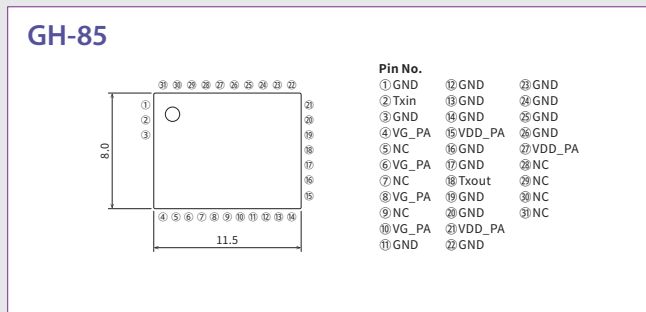


★:開発品 HEMT: High Electron Mobility Transistor

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) の委託研究の成果の一部を活用しています。

パッケージ外形図 (Top View)

Unit: mm



インターネット・高速データ通信など通信ネットワークは急速に発展しています。
三菱電機の高周波デバイスは、ICT社会の実現に向けて
最適なソリューションを提供いたします。



製品一覧表

GH-85



■ 移動通信システム基地局用 GaN HEMT

Type Number	Peak Output Power [dBm]	Average Output Power [dBm]	Power Gain [dB]	Power Added Efficiency [%]	Frequency [GHz]	Drain-Source Voltage [V]	Package Outline
MGFS48G38MB	49	39	28.5	43	3.3~3.8	42	GH-85
MGFS52G38MB	51.5	42	29	40	3.3~3.8	46	GH-85
MGFS52G40MB	51.5	42	30	41	3.6~4.0	46	GH-85

Ta=25°C

■ 衛星通信用高出力 GaN HEMT

GF-69



GF-68



GF-65



Type Number	Output Power [dBm]	Linear Power Gain [dB]	Power Added Efficiency [%]	Offset Frequency	Frequency [GHz]	Drain-Source Voltage [V]	Drain Current [A]	Thermal Resistance [°C/W]		Package Outline
								Typ.	Max.	
マルチキャリア通信対応 Ku帯 GaN HEMT										
MGFK48G2732A	48.3	11	31	~400MHz	12.75~13.25	24	1.44	0.8	1	GF-68
MGFK48G3745A	48.3	11	31	~400MHz	13.75~14.5	24	1.44	0.8	1	GF-68
MGFK45G3745A	45.3	9.5	30	~400MHz	13.75~14.5	24	0.72	1.6	2	GF-68
シングルキャリア通信対応 Ku帯 GaN HEMT・MMIC										
MGFK45G2732	45.3	9.5	31	~5MHz	12.75~13.25	24	0.72	1.6	2	GF-68
MGFK48G2732	48.3	12	33	~5MHz	12.75~13.25	24	1.44	0.8	1	GF-68
MGFK50G3745	50	10	30	~5MHz	13.75~14.5	24	2.4	0.4	0.6	GF-69
MGFK48G3745	48.3	12	33	~5MHz	13.75~14.5	24	1.44	0.8	1	GF-68
MGFK45G3745	45.3	9.5	31	~5MHz	13.75~14.5	24	0.72	1.6	2	GF-68
MGFG5H1503	43	24	20	~5MHz	13.75~14.5	24	2.7	1.2	1.5	GF-65
Ka帯 GaN MMIC										
MGFGC5H3103*	41.5	24	32	-	27.5~31.0	22	0.27	2.6	-	ベアチップ
MGFGC5H3102*	39	24	34	-	27.5~31.0	22	0.14	5.2	-	ベアチップ

Ta=25°C ★:開発品

高周波デバイス 形名の見方

■ 移動通信システム基地局用

MGFS48G38MB

A B C D E F

- A 周波数帯 — S:S-band
- B 出力電力 — ex.48=48dBm
- C デバイス構造 — G:GaN HEMT
- D 周波数 — ex.38=~3.8GHz
- E パッケージ — ex.M:モジュール
- F 連番

■ 衛星通信用 (内部整合型)

MGFK50G3745

A B C D

- A 周波数帯 — K:Ku-band
- B 出力電力 — ex.50=50dBm=100W(typ.)
- C デバイス構造 — G:GaN HEMT
- D 周波数 — ex.3745=13.75~14.5GHz

■ 衛星通信用 (MMIC)

MGFGC5H3103

A B C D E

- A デバイス構造 — G:GaN HEMT
- B 製品形態 — C:ベアチップ
- C 機能 — 5H:高出力MMIC (27dBm以上)
- E 周波数上限 — ex.31=31GHz
- F 連番

高周波デバイスは、すべての製品が **RoHS 指令** (2011/65/EU、(EU) 2015/863) に準拠しています。

RoHS: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

三菱高周波デバイス

安全設計に関するお願い (・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用の際の留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機または、第三者に帰属する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
- ・三菱半導体製品のご購入にあたりましては、事前に三菱電機または代理店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期するため、慎重に制作したものです。本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際は、三菱電機または代理店へご照会ください。
- ・本資料に含まれる製品や技術をお客様が他の国へ提供する場合は、日本およびその他の国の輸出管理規制等を遵守する必要があります。また、日本、その他の仕向け地における輸出管理規則に抵触する迂回行為や再輸出は禁止します。
- ・本資料の一部または全部の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お支払いの点がございましたら三菱電機または代理店までご照会ください。

三菱電機株式会社

半導体・デバイス事業本部 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 (東京ビル)

三菱電機 高周波デバイス ウェブサイト

www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/hf/



ご相談・お問い合わせ

www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/hf/contact/



営業お問合せ窓口

(2026年6月1日現在)

代理店	三菱電機本社・支社・支店
本社地区	本 社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号(東京ビル) 半導体・デバイス第一事業部 半導体・デバイス第二事業部
リョーサン菱洋株式会社 (03) 3862-2591 萬世電機株式会社 東京支店 (03) 3219-1801 東北第二支店 (022) 266-3800 株式会社たけびし 東京支店 (03) 3258-6120 松本支店 (0263) 36-8011 東海エレクトロニクス株式会社 東京支店 (03) 3704-2581 横浜支店 (045) 474-1011 熊谷支店 (048) 527-1620 株式会社立花エレテック 東日本支社 (03) 6400-3619 三島支店 (055) 980-5710 株式会社 RYODEN 本社(東日本支社) (03) 5396-6224 株式会社コシダテック (03) 5789-1615 株式会社カナデン (03) 6747-8860 加賀デバイス株式会社 (03) 5657-0144 東北支店 (022) 266-3118 協栄産業株式会社 (03) 4241-5524 日立営業所 (029) 272-3911 群馬営業所 (027) 327-4345 新潟営業所 (025) 281-1171 東北支店 (022) 721-2577 北海道支店 (011) 272-1342	
中部支社地区	中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号(大名古屋ビルヂング) 半導体・デバイス部
リョーサン菱洋株式会社 名古屋第三支店 (052) 203-0277 東海エレクトロニクス株式会社 (052) 261-3211 株式会社立花エレテック 中部支社 (052) 223-3519 エレックヒシキ株式会社 (052) 704-2121 株式会社 RYODEN 中日本支社 (052) 211-1217 メルコムモビリティソリューションズ株式会社 静岡事業所 (054) 286-2215 浜松office (053) 450-3162 浜松事業所 (050) 9002-6674 沼津営業所 (050) 9002-6678 協栄産業株式会社 名古屋支店 (052) 564-5571 岡谷銅機株式会社 名古屋本店 (052) 204-8302 刈谷支店 (0566) 21-3212	
関西支社地区	関西支社 大阪府大阪市北区大深町4番20号(グランフロント大阪タワーA) 半導体・デバイス部
リョーサン菱洋株式会社 大阪第二支店 (06) 6455-5120 萬世電機株式会社 (06) 6454-8234 京都第二支店 (075) 371-5751 株式会社たけびし (075) 325-2211 株式会社立花エレテック (06) 6539-2707 大阪支店 (06) 6341-5081 北陸支店 (076) 233-3505 東海エレクトロニクス株式会社 大阪支店 (06) 6310-6115 株式会社 RYODEN 西日本支社 (06) 4797-3956 山陽三菱電機販売株式会社 (082) 243-9300 姫路営業所 (050) 9002-4877 加賀デバイス株式会社 営業統括二部 (06) 6105-0449 広島事業所 (082) 227-5411 高松事業所 (087) 885-3913 株式会社カナデン 関西支社 (06) 6763-6809 協栄産業株式会社 大阪営業所 (06) 6343-9663	
九州支社地区	パワーデバイス製作所 福岡県福岡市西区今宿東一丁目1番1号 半導体・デバイス第一事業部 パワーデバイス営業部 第三営業課 パワーデバイス製作所駐在
リョーサン菱洋株式会社 福岡第二支店 (092) 474-4311 株式会社たけびし 九州支店 (092) 473-7580 株式会社 RYODEN 西日本支社 (06) 4797-3956 福岡事業所 (092) 736-5759 株式会社カナデン 九州支店 (093) 561-6483	